

Fortunato Pezzimenti ha conseguito la Laurea in Ingegneria Elettronica ed il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria Elettronica presso l'Università Mediterranea degli Studi di Reggio Calabria, rispettivamente nel maggio 2000 e nel marzo 2004.

Egli è attualmente Professore Associato di Elettronica presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, delle Infrastrutture e dell'Energia Sostenibile (DIIES), dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria.

In passato la sua attività di ricerca ha riguardato il progetto e la simulazione numerica di transistor bipolarì ad etero-giunzione (HBT) in GaAs e SiGe con emettitore sottile in silicio amorfo idrogenato (a-Si:H), oltre che lo sviluppo di blocchi logici aritmetici veloci come sommatori Manchester riconfigurabili ed il progetto di microsensori compatibili con la tecnologia CMOS.

I suoi attuali interessi di ricerca includono sia il progetto e la caratterizzazione elettronica di dispositivi di potenza bipolarì realizzati con semiconduttori ad ampia bandgap, come il carburo di silicio 4H (4H-SiC) e il nitruro di gallio (GaN), per applicazioni ad alta tensione ed ad alta temperatura, sia il progetto e la modellizzazione di celle solari multi giunzione ad alta efficienza. In relazione ai temi di ricerca presentati, egli è autore o coautore di circa 100 pubblicazioni su riviste internazionali o comunicazioni a congressi internazionali.

La sua attività didattica presso il DIIES dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria è inerente i corsi di Dispositivi Elettronici a Semiconduttore, Elettronica Analogica e Digitale, Microelettronica e Progettazione VLSI.

Fortunato Pezzimenti received the Laurea and Ph.D. degrees in Electronic Engineering from the Mediterranea University of Reggio Calabria, Reggio Calabria, Italy, in May 2000 and March 2004, respectively.

He is now Associate Professor of Electronics with the Department of Information Engineering, Infrastructure and Sustainable Energy (DIIES), Mediterranea University of Reggio Calabria.

His research has involved the design and numerical simulation analysis of GaAs and SiGe hetero-junction bipolar transistors (HBT) with an extremely thin hydrogenated amorphous silicon (a-Si:H) emitter, and also the development of fast and energy-efficient arithmetic building blocks, such as reconfigurable Manchester carry-bypass adders, and the design of miniature sensors that can be integrated in standard CMOS microchips.

His current research interests include the design and electrical characterization of bipolar power devices based on wide bandgap semiconductors, in particular on silicon carbide 4H (4H-SiC) and gallium nitride (GaN) for high-voltage and high-temperature applications, as well as the design and modelling of high-efficiency multi-junction solar cells.

Referring to the above research topics, he is author or co-author of about 100 publications on international journals and international conference proceedings.

His teaching activity with DIIES, Mediterranea University of Reggio Calabria, concerns the courses of Semiconductors Devices, Analog and Digital Electronics, Microelectronics, and VLSI design.